

RISeT – Rete Informativa Scienza e Tecnologia

<i>Mittente</i>	Ambasciata d'Italia a Seoul (Corea) Ufficio Addetto Scientifico e Tecnologico – A.Tata
Titolo: Corea – Memoria DRAM da 30 nanometri	
<i>Parole chiave</i>	chips, memorie, DRAM, ICT, Hynix, Corea
<i>Settori/sotto settori</i>	08, 11
<i>Tipo di informazione</i>	Progressi di S&T
<i>Redazione</i>	Antonino Tata
<i>E-mail/Tel./fax</i>	<u>sciencekor@yahoo.it</u> – <u>scitec.ambseoul@esteri.it</u> tel. +82-2-796-0491 / fax +82-2-793-5311
<i>Sito web</i>	www.ambseoul.esteri.it/ambasciata_seoul

Testo:

La Soc. coreana Hynix Semiconductor Inc., secondo produttore mondiale (dopo la coreana Samsung Electronics) di memorie DRAM (Dynamic Random Access Memory) e NAND-Flash (NotAND Memory), ha comunicato di avere sviluppato una nuova memoria DRAM (Dynamic Random Access Memory), della famiglia DDR3, basata sulla tecnologia da 30 nanometri (e capacità 4 Gigabit) che presenta una velocità superiore rispetto a qualsiasi precedente analogo componente commerciale. Le capacità manifatturiere del nuovo chip risultano molto migliorate (+70%) con conseguente riduzione dei costi di produzione.

Si tratta della prima memoria DRAM da 30 nanometri a livello mondiale e la concorrenza di Taiwan e Giappone risulta utilizzare ancora la tecnologia da 50-60 nanometri.

La memoria DRAM sviluppata entrerà in produzione commerciale dal primo trimestre 2011 con possibilità applicative in apparecchiature mobili quali telefoni cellulari, macchine fotografiche digitali, laptops, etc.

Nello specifico settore delle memorie per apparecchiature mobili le Società coreane SE (Samsung Electronics) ed Hynix guidano le classifiche mondiali (con il primo e secondo posto), con una copertura globale del 61.6% del mercato delle memorie DRAM (dati 2010) e del 49.3% di quelle NAND-Flash.

<i>Fonte dell'informazione</i>	Hynix Semiconductor: http://www.hynix.com
<i>Contatto locale</i>	-
<i>Data</i>	04.01.2011